

# 高纯度Ptfе湿法清洗花篮 单晶圆蚀刻架 可定制4英寸掩模板载具

货号: PL-CP66



## 简介

高纯度PTFE湿法清洗花篮为半导体晶圆加工提供了卓越的耐化学性。这些可定制的蚀刻架确保在苛刻的实验室和工业环境中，对敏感基底进行无污染的浸没式清洗和处理。联系我们获取定制含氟聚合物解决方案。

## 了解更多

应用	描述	主要优势
半导体晶圆清洗	将硅晶圆浸入RCA清洗 ( SC-1和SC-2 ) 序列中以去除有机和金属污染物。	防止交叉污染并确保高纯度加工。
湿法化学蚀刻	在高温下使用氢氟酸或磷酸浴对薄膜 ( SiO <sub>2</sub> 、Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> ) 进行精密蚀刻。	在强酸环境中保持结构完整性。
掩膜板处理	光刻中使用的光掩膜的专用处理和清洗，以确保无缺陷的图形转移。	精密开槽防止接触导致的掩膜表面损伤。
太阳能电池制造	用于制绒和磷硅玻璃 ( PSG ) 去除的硅晶圆批量处理。	在大批量生产周期中具有高吞吐量 and 耐用性。
导电玻璃制备	用于光电和显示器制造的ITO/FTO涂层玻璃的清洗和制备。	最少的接触点防止敏感导电层的划伤。
MEMS开发	在复杂的牺牲层蚀刻过程中处理多层微机电系统。	化学惰性确保精密微结构不受损害。
实验室规模研发	在学术和工业研究中进行小批量基底处理，以开发新材料。	多功能定制允许非标准基底的形状和尺寸。

参数	规格详情 ( 型号 : PL-CP66 )
材料成分	100% 高纯度原生 PTFE ( 聚四氟乙烯 )
最高工作温度	+260°C ( 连续 )
最低工作温度	-200°C
化学相容性	通用 ( pH 0-14 ) ; 耐HF、王水、食人鱼溶液
标准基底尺寸	4 英寸 (100mm) - 可定制所有直径
槽配置	提供单晶圆或多晶圆变体
槽深度/宽度	可根据基底厚度和稳定性需求完全定制
手柄设计	固定垂直、可拆卸或摆动式手柄 ( 可定制 )
制造方法	精密CNC加工 ( 零模具污染 )
表面光洁度	高光滑度、低孔隙率加工表面